

**ЗАО «ЭПЛ»****ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ**

124482, Москва, Зеленоград, п/я167, ЗАО «ЭПЛ». Тел./факс (495) 532-81-95, тел.(495) 532-93-36

E-mail: epl@epl.ru, <http://www.epl.ru>**КТД 8278 (А,А9,Б,Б9,В,В9)****Мощный NPN кремниевый транзистор**

АДКБ.432140.165 ТУ

КТД8278 - биполярный эпитаксиально-планарный транзистор Дарлингтона с защитным встроенным диодом.

Прибор предназначен для применения

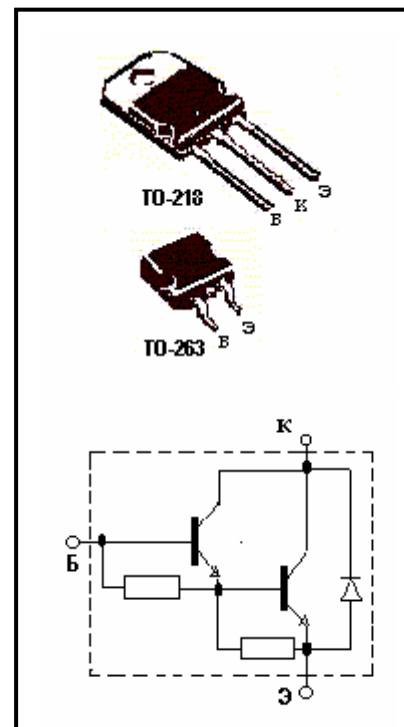
в усилителях низкой частоты, стабилизаторах тока и напряжения, импульсных усилителях мощности, повторителях, переключающих устройствах, электронных системах управления защиты и автоматики, для коммутации тока в обмотке возбуждения генераторов переменного тока.

Отличительные особенности:

- сочетание низкого напряжения насыщения $U_{кэо\text{нас}}$ с высоким граничным напряжением $U_{кэо\text{гр}}$
- высокий коэффициент усиления $h_{21э} > 1000$ на начальной стадии характеристики при токе коллектора $I_k = 200\text{mA}$

Аналоги: КТ827, КТ829АТ, КТ8116, КТД8246, КТД8253, SGSD93ST, SGSD93G, SGSD93F, SGSD93E.**Выпускается в двух корпусных исполнениях:**

в пластмассовых корпусах ТО-220, ТО-263 и в бескорпусном исполнении - кристалл для использования в гибридных схемах.

**Предельно-допустимые режимы эксплуатации.**

Параметры	Обозначение	КТД8278 А,А9	КТД8278 Б,Б9	КТД8278 В,В9	Ед. измер.
Напряжение коллектор-база	$U_{кбо}$	200	180	160	В
Напряжение коллектор-эмиттер	$U_{кэо}$	180	140	120	В
Напряжение эмиттер-база	$U_{эбо}$	4,5	4,5	4,5	В
Ток коллектора постоянный	I_k	20	20	20	А
Ток коллектора импульсный	$I_{ки}$	40	40	40	А
Ток базы постоянный	I_b	2	2	2	А
Рассеиваемая мощность коллектора	$P_k \text{ max}$	75	75	75	Вт
Температура перехода	T_j	-65÷+150	-65÷+150	-65÷+150	°С

Основные электрические параметры (Ткорп.=25 °С).

Параметры	Обозначение	Норма	Режим	Группа	Ед. Изм.
Обратный ток коллектор-эмиттер	$I_{кэо}$	≤50	$U_{кэ}=180\text{В}, R_B=\infty$	А,А9	мкА
			$U_{кэ}=140\text{В}, R_B=\infty$	Б,Б9	
			$U_{кэ}=120\text{В}, R_B=\infty$	В,В9	
Обратный ток коллектор-база	$I_{кбо}$	≤50	$U_{кб}=U_{кэо\text{гр}}+20\text{В}$	все	мкА
Напряжение коллектор-эмиттер граничное	$U_{кэо\text{гр}}$	≥180	$I_k=100\text{mA}, I_b=0$	А,А9	В
		≥140		Б,Б9	
		≥120		В,В9	
Обратный ток эмиттер-база	$I_{эбо}$	≤2	$U_{эб}=4\text{В}, I_k=0$	все	мА
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	$U_{кэ.нас}$	≤1,4	$I_k=5\text{A}, I_b=8\text{mA}$	все	В
Напряжение насыщения база-эмиттер	$U_{бэ.нас}$	≤2,1	$I_k=5\text{A}, I_b=8\text{mA}$	все	В
Статический коэффициент передачи тока	$h_{21э}$	≥1000	$I_k=0,2\text{A}, U_{кэ}=1,5\text{В}$	все	-
		≥1000	$I_k=5\text{A}, U_{кэ}=2,5\text{В}$		

«EPL» Semiconductor Devices Production.

124482, Moscow, Zelenograd, m/b167, «EPL Ltd». Tel/fax +7(495) 532-81-95, tel.+7(495) 532-93-36.

<http://www.epl.ru>, E-mail: epl@epl.ru